## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-232959

(43)Date of publication of application: 05.09.1995

(51)Int.Cl.

CO4B 35/10 B23P 15/28 // B23B 27/14

(21)Application number: 06-106630

. 00-100030

(71)Applicant: KOBE STEEL LTD

(22)Date of filing: 20.05.1994

(72)Inventor: TSUCHIDA TAKEHIRO

KANAMARU MORIYOSHI

TATENO TSUNEO

(30)Priority

Priority number: 05322654

Priority date: 21.12.1993

Priority country: JP

#### (54) ALUMINA-BASED CERAMICS AND ITS PRODUCTION

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain SiC whisker-contg. Al2O3-based ceramics having sufficiently high denseness as well as sufficiently high strength and toughness even in the case of large-sized ceramics of a complex shape. CONSTITUTION: A mixture contg. 5-30wt.% SiC whiskers, 3-30wt.% one or more kinds of oxides of Mg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y and rare earth elements as a sintering aid and Al2O3 powder as a base material or further contg. 0.5-40wt.% one or more kinds of compds. each consisting of one or more kinds of groups IVa, Va and VIa transition elements of the Periodic Table and one or more among C, N and B is press-compacted and subjected to pressureless sintering at 1,500-1,900° C in an atmosphere of inert gas contg. nitrogen.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-232959

(43)公開日 平成7年(1995)9月5日

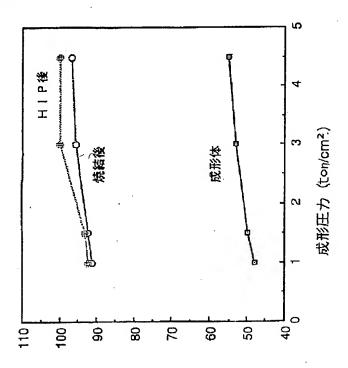
(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C04B 35/10				
B23P 15/28	I		•	
// B23B 27/14	В			
			CO4B 35/10	E
			審査請求未	:請求 請求項の数13 OL (全14頁)
(21)出願番号	特願平6-106	6 3 0	(71)出顧人	000001199
				株式会社神戸製鋼所
(22)出願日	平成6年(199	4) 5月20日		兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18
				号
(31)優先権主張番号	特願平5-322	6 5 4	(72)発明者	土田 武広
(32)優先日	平5 (1993)	12月21日		兵庫県明石市魚住町金ケ崎西大池179番
(33)優先権主張国	日本(JP)			1 株式会社神戸製鋼所明石工場内
			(72)発明者	金丸 守賀
				兵庫県明石市魚住町金ケ崎西大池179番
				1 株式会社神戸製鋼所明石工場内
			(72)発明者	立野 常男
				兵庫県明石市魚住町金ケ崎西大池179番
				1 株式会社神戸製鋼所明石工場內
	•		(74)代理人	弁理士 明田 莞

#### (54) 【発明の名称】アルミナ基セラミックス及びその製造方法

#### (57) 【要約】

【構成】 SiC ウイスカを  $5 \sim 30$ wt %含有すると共に、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y, 希土類元素の酸化物の1種以上を  $3 \sim 30$ wt %含有し、基材として Al, 0, 粉末を含有する混合体、或いは更に元素周期表 IVa、Va、VIa族の遷移元素の1種以上とC, N, Bの1種以上とからなる化合物の1種以上を $0.5 \sim 40$ wt %含有する混合体を、加圧成形した後、窒素を含有する不活性ガス雰囲気中において $1500 \sim 1900$  で常圧焼結することを特徴とする Al, 0, 基セラミックスの製造方法、又、かかる製造方法により得られる Al, 0, 基セラミックス。

【効果】 複雑形状及び大型のものであっても、充分な強度・靭性を有すると共に充分緻密なSiC ウイスカ含有 Al: 0, 基セラミックスが得られるようになる。



(%) 類密 於 財

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 SiC ウイスカを5~30w1%含有すると共 に、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y及 び希土類元素の酸化物の1種以上を3~30wt%含有し、 且つ窒素含有量が0.2v1%以上である Al, 0, 基焼結体より なることを特徴とする Al,O,基セラミックス。

1

【請求項2】 SiC ウイスカを5~30v1%含有し、元素 周期表のIVa、Va、VIa 族の選移元素の1種以上とC. N, Bの1種以上とからなる化合物の1種または2種以 上を 0.5~40w1%含有すると共に、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y及び希土類元素の酸化物の 1種以上を3~30mt%含有し、且つ窒化物中窒素以外の 窒素含有量が0.2m1%以上である Al, 0, 基焼結体よりなる ことを特徴とする Al. O. 基セラミックス。

【請求項3】 前記 Al, 0, 基焼結体の気孔率が1%以下 である請求項1又は2記載の Al.O,基セラミックス。

【請求項4】 SiC ウイスカを5~30w1%含有すると共 に、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y, 希土類元素の酸化物の1種以上を3~30w1%含有し、基 材として Al.O.基セラミックス原料粉末を含有する混合 20 体を成形した後、窒素を含有する不活性ガス雰囲気中に おいて1500~1900℃で常圧焼結することを特徴とする A 1,0,基セラミックスの製造方法。

【請求項5】 SiC ウイスカを5~30wt%含有し、元素 周期表のIVa、Va、VIa 族の遷移元素の1種以上とC, N, Bの1種以上とからなる化合物の1種または2種以 上を 0.5~40w1%含有すると共に、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y及び希土類元素の酸化物の 1 種または2 種以上を3~30w1%含有し、基材として A l,0,基セラミックス原料粉末を含有する混合体を加圧成 30 れてきた Si,N,系セラミックスに比べると、強度及び靭 形した後、窒素を含有する不活性ガス雰囲気中において 1500~1900℃で常圧焼結することを特徴とする Al. 0, 基 セラミックスの製造方法。

【請求項6】 前記常圧焼結後に得られる焼結体を、更 に窒素を含有する不活性ガス雰囲気中において1200~17 00℃で熱間等方圧プレスして焼結体気孔率を1%以下に する請求項4又は5記載の Al:0,基セラミックスの製造 方法。

【請求項7】 前記焼結助剤として MgOを0.2 ~10wt% 、2rO, を0.2 ~20wi% 且つY, 0, を1.0 ~20wi% 含有す ると共に、これらの合計含有量が20xt%以下である請求 項1、2又は3記載の Al.O. 基セラミックス。

前記 Al, 0, 基焼結体の Al, 0, 粒径が 5 μ n 以下である請求項1、2、3又は7記載の Al,0,基セ ラミックス。

【請求項9】 前記SiC ウイスカが平均アスペクト比: 3以上、直径:0.4~1.5 μm である請求項1、2、 3、7又は8記載の Al, 0, 基セラミックス。

【請求項10】 前記SiC ウイスカの平均アスペクト比 と Al.0,基焼結体中含有量との積が400 以下である請求 50 , にSiC ウイスカを添加すると共に焼結助剤としてMg,

項1、2、3、7、8又は9記載の Al<sub>2</sub>0<sub>2</sub>基セラミック

【請求項11】 前記混合体を得るための混合をボール ミルにより行い、その際の混合時間を2~200 時間、且 つt≥2c-20の式を充たす時間にする請求項4、5又 は6記載の Al.O. 基セラミックスの製造方法。但し、上 記式 t ≥2c-20において c は混合体中のSiC ウイスカ含 有量(wi%)、tは混合時間(h)を示すものである。

【請求項12】 前記混合体を得るための混合を湿式混 10 合法により行い、該混合後成形前における混合体の乾燥 をスプレー乾燥法により行う請求項4、5、6又は11記 戯の Al, 0, 基セラミックスの製造方法。

【請求項13】 前記混合体の成形の際の成形圧力を3. Oton/cm<sup>1</sup>以上とする請求項4、5、6、11又は12記載の Al, 0, 基セラミックスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、 Al, O, (アルミナ) 基 セラミックス及びその製造方法に関し、特には、高強 度、靭性、耐摩耗性を必要とする切削工具やダイス抽伸 プラグ等の治工具類の他、耐摩耗性、靭性、耐衝撃性を 必要とするポンプ・パルプやメカニカルシール等の機械 部品類に用いて好適な Al, 0, 基セラミックス及びその製 造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】Al,0,基セラミックスは、高強度を有す ると共に耐食性、耐酸化性、耐摩耗性に優れ、機械部品 や治具・工具材に適したセラミックスとして知られてい るが、従来エンジニアリングセラミックスとして多用さ 性が劣っている。

【0003】この Al,0,基セラミックスの強度・靭性の 改善方法が検討され、その結果、米国特許第4543345 号 公報に記載の如く、SiC ウイスカを添加する方法が開発 され提案されており、優れた靭性が得られている。しか し、このSiC ウイスカを添加した Al.O.基セラミックス (以降、SiC ウイスカ含有 Al, O, 基セラミックスとい う)はホットプレスにより製造されており、この製造方 法では複雑な形状のものができない上、大型のものの製 40 造が困難であるという問題点がある。

【0004】そこで、この問題点を解決するために常圧 焼結法の適用が試みられている。例えば、Terry N Tige rsらは、J. Am. Ceram. Soc 73[5](1990)1440-1442 に記載 の如く、SiC ウイスカのアスペクト比及び焼結助剤の量 を変え、常圧焼結することを試みている。又、Young-Wo ok Kimらは、J. Mal. Sci 26(1991)1316-1320 に記載の如 く、焼結前の成形体に水酸化アルミを析出させる特殊な 方法を用い、常圧焼結することを試みている。一方、本 発明者らは、特開平4-124058号公報に記載の如く、Al, 0

Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y及び希土類元素の酸化物を 添加することを開示している。尚、これら常圧焼結はSi C ウイスカと雰囲気ガスとの反応を避けるためにアルゴ ・ン等の不活性雰囲気中において1500~1900℃で行われて いる。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、前記従来の 常圧焼結法によりSiC ウイスカ含有 Al.O.基セラミック スを製造する場合、SiC ウイスカが焼結を阻害するた め、充分に緻密な焼結体を得るのは非常に難しいという 10 問題点がある。

【0006】そこで、この対策として、SiC ウイスカが 焼結を阻害せず、充分に緻密な焼結体が得られる程度に SiC ウイスカの添加量を減少させたり、J. Am. Ceram. Soc 73[5](1990)1440-1442 に記載の如くSiC ウイスカのア スペクト比を著しく小さくしたり、焼結助剤の添加量を 多くしたりすると、それらに起因して強度・靭性が著し く低下し、充分な強度・靭性が得られなくなる。従っ て、かかる強度・靭性の低下を招くことなく、充分な強 度・靭性を有すると共に充分緻密な焼結体よりなるSiC ウイスカ含有 Al,0,基セラミックスを常圧焼結法により 製造し得る技術の開発が望まれる。

【0007】尚、米国特許第4543345 号公報に記載の方 法の如くホットプレスにより製造するのでは、簡単な形 状で且つ小さなものしか得られず、又、著しく手間がか かるという現状にある。

【0008】本発明はこの様な事情に着目してなされた ものであって、その目的は、従来のものがもつ以上のよ うな問題点を解消し、ホットプレスではなく複雑形状及 て得られるSiC ウイスカ含有Al,O,基セラミックスであ って、充分な強度・靭性を有すると共に充分緻密な焼結 体よりなる Al, O, 基セラミックスを提供し、又、常圧焼 結法を基本工程として、充分な強度・靭性を有すると共 に充分緻密な焼結体よりなるSiC ウイスカ含有Al, 0,基 セラミックスを製造し得る Al, 0, 基セラミックスの製造 方法を提供しようとするものである。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、本発明に係る Al.O. 基セラミックス及び Al.O. 基 40 セラミックスの製造方法は次のような構成としている。 即ち、請求項1に記載の Al, O, 基セラミックスは、SiC ウイスカを5~30w1%含有すると共に、焼結助剤として Mg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y及び希土類元素の酸化 物の1種以上を3~30vt%含有し、且つ窒素含有量が0. 2w1%以上であるA1.0,基焼結体よりなることを特徴とす る Al,O,基セラミックスである。

【0010】請求項2に記載の Al, 0, 基セラミックス は、SiC ウイスカを5~30wl%含有し、元素周期表のIV a、Va、Vla 族の遷移元素の1種以上とC, N, Bの1 50 種以上とからなる化合物の1種以上を 0.5~40w1%含有 すると共に、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y及び希土類元素の酸化物の1種または2種以上を 3~30\*1%含有し、且つ窒化物中窒素以外の窒素含有量 が0.2m1%以上である Al, 0, 基焼結体よりなることを特徴 とする Al, O, 基セラミックスである。

【0011】請求項3に記載の Al,0,基セラミックス は、前記 Al.O. 基焼結体の気孔率が1%以下である請求 項1又は2記載の Al,O,基セラミックスである。

【0012】請求項4に記載の Al, 0, 基セラミックスの 製造方法は、SiC ウイスカを5~30wt%含有すると共 に、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y, 希土類元素の酸化物の1種または2種以上を3~30g1% 含有し、基材として Al, O, 基セラミックス原料粉末を含 有する混合体を成形した後、窒素を含有する不活性ガス 雰囲気中において1500~1900℃で常圧焼結することを特 徴とする Al, O, 基セラミックスの製造方法である。

【0013】請求項5に記載の製造方法は、SiC ウイス 力を5~30w1%含有し、元素周期表のIVa、Va、VIa族 20 の遷移元素の1種以上とC, N, Bの1種以上とからな る化合物の1種または2種以上を 0.5~40w1%含有する と共に、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, 2r, Cr, Ni, Y及び希土類元素の酸化物の1種または2種以上を3~ 30w1%含有し、基材として Al, 0, 基セラミックス原料粉 末を含有する混合体を加圧成形した後、窒素を含有する 不活性ガス雰囲気中において1500~1900℃で常圧焼結す ることを特徴とする Al,O,基セラミックスの製造方法で

【0014】請求項6に記載の製造方法は、前記常圧焼 び大型のものの製造が可能な常圧焼結法を基本工程とし 30 結後に得られる焼結体を、更に窒素を含有する不活性ガ ス雰囲気中において1200~1700℃で熱間等方圧プレス (以降、HIP という) して焼結体気孔率を1%以下にす る請求項4又は5記載の Al, 0, 基セラミックスの製造方 法である。

> 【0015】請求項7に記載の Al.0,基セラミックス は、前記焼結助剤として MgOを0.2 ~10wt% 、2rO<sub>2</sub>を0. 2 ~20wi% 且つY, 0, を1.0 ~20wi% 含有すると共にこれ らの合計含有量が20wik 以下である請求項1、2又は3 記載の Al, 0, 基セラミックスである。請求項8に記載の Al, 0, 基セラミックスは、前記 Al, 0, 基焼結体の Al, 0, 粒径が5μm以下である請求項1、2、3又は7記載の Al. 0, 基セラミックスである。請求項9に記載の Al. 0, 基セラミックスは、前記SiC ウイスカが平均アスペクト 比: 3以上、直径: 0.4 ~1.5 μm である請求項1、 2、3、7又は8記載の Al.O. 基セラミックスである。 請求項10に記載の Al.O.基セラミックスは、前記SiC ウ イスカの平均アスペクト比と Al, 0, 基焼結体中含有量と の積が400 以下である請求項1、2、3、7、8又は9 記載の Al, 0, 基セラミックスである。

【0016】請求項口に記載の製造方法は、前記混合体

20

を得るための混合をポールミルにより行い、その際の混 合時間を 2~200 時間且つ t ≥ 2 c - 20の式〔但し、c は混合体中のSiC ウイスカ含有量(wik)、 t は混合時間 (h)〕を充たす時間にする請求項4、5又は6記載の A 1,0,基セラミックスの製造方法である。請求項12に記載 の製造方法は、前記混合体を得るための混合を湿式混合 法により行い、該混合後成形前における混合体の乾燥を スプレー乾燥法により行う請求項4、5、6又は11記載 の Al.O. 基セラミックスの製造方法である。請求項13に 記載の製造方法は、前記混合体の成形の際の成形圧力を 10 3.01on/cm<sup>2</sup>以上とする請求項4、5、6、11又は12記載 の Al, 0, 基セラミックスの製造方法である。

#### [0017]

【作用】本発明は、常圧焼結法を基本工程として、充分 な強度・靭性を有すると共に緻密な焼結体が得られる技 術を開発すべく研究をしていたとき、SiC ウイスカ、焼 結助剤及び Al, 0, 基セラミックス原料粉末の混合成形体 を常圧焼結するに際し、焼結助剤としてMg, Si, Ca, T i, Zr, Cr, Ni, Y, 希土類元素の酸化物の1種または 2種以上(以降、Mgの酸化物等という)を使用した場 合、意外にも焼結による緻密化が焼結雰囲気の影響を受 け、窒素を含有する不活性ガス雰囲気(以降、窒素含有 不活性ガス雰囲気という)中で焼結すると焼結助剤を有 効に働かせられ、充分な強度・靭性を確保した上で充分 な緻密化が図れることを知見し、主にはかかる知見に基 づき完成されたものである。

【0018】即ち、SiC ウイスカ、焼結助剤及び Al, 0, 基セラミックス原料粉末の混合成形体を常圧焼結する と、SiC ウイスカ及び焼結助剤を含有する焼結体が得ら れる。ここで、焼結の際の窒素含有不活性ガス雰囲気の 30 圧)である。 作用を説明する前に、その作用と関連するSiC ウィスカ 及び焼結助剤の作用について先ず説明する。

【0019】SiC ウイスカは、プルアウト・ブリッジン グ・クラックディフレクション等の作用により、靭性を 向上させるが、その含有量が5 wt %未満になると靭性向 上の効果が不充分であり、30w1%を超えると緻密化が困 難となるため強度が低下してしまう。従って、含有量は 5~30w1%とする必要がある。

【0020】焼結助剤の選択は常圧焼結法においては重 要な要素の一つであり、その焼結助剤の役割は、焼結中 40 に液相を発生し、絡み合ったSiC ウイスカの再配列を促 して焼結体の密度を向上(緻密性を向上)させることに ・ある。かかる焼結助剤としてMgの酸化物等が好適であ り、これら焼結助剤はいづれもSiC ウイスカの劣化する 温度以下で液相となり、SiC ウイスカとの著しい反応も なく、しかもSiC ウイスカとの濡れ性が良いため、効果 的に焼結体の密度を向上させることができるが、これら 焼結助剤の含有量が3 w1%未満になるとその効果は小さ くて不充分であり、30w1%超になると相対的に Al.O, 虽

従って、焼結助剤としてのMgの酸化物等の含有量は3~ 30v1%とする必要がある。

【0021】次に、焼結の際の窒素含有不活性ガス雰囲 気の作用を説明する。真空、Arガス雰囲気において焼結 すると、焼結中に焼結助剤(液相となった焼結助剤)の 蒸発が激しく、そのため焼結助剤の働き(絡み合ったSi C ウイスカの再配列を促す働き)が損なわれ、焼結体の 緻密性向上(緻密化)が図れず、充分緻密な焼結体を得 ることができない。

【0022】これに対し、窒素含有不活性ガス雰囲気中 において焼結すると、焼結助剤の蒸発が抑制され、その ため緻密化が促進され、充分に緻密化された焼結体が得 られるという知見が得られた、そして、この焼結体は窒 素含有量が0.2~18以上となることがわかった。この原因 については明らかではないが、焼結の際に液相となった 焼結助剤中に窒素が含有され、その液相の気化温度が上 昇するためと考えられる。但し、このように窒素含有不 活性ガス雰囲気中で焼結しても、焼結温度が1900℃を超 えると焼結助剤の蒸発が激しくなり、充分緻密な焼結体 を得ることができなくなり、1500℃未満になると焼結助 剤の充分な液相が生じないため、焼結助剤の働きが弱 く、充分緻密な焼結体を得ることができなくなるので、 焼結温度は1500~1900℃とする必要がある。

【0023】ここで、窒素含有不活性ガス雰囲気とは、 不活性ガス雰囲気であって窒素を含有する雰囲気のこと であり、より具体的には窒素ガス雰囲気、又は、窒素ガ スと窒素ガス以外の不活性ガス(例えばAr)との混合ガ ス雰囲気のことである。この窒素含有不活性ガス雰囲気 の圧力は、焼結が常圧焼結であることから、常圧 (1気

【0024】本発明は、以上の知見に基づき完成された。 ものであり、本発明に係る Al,0,基セラミックスの製造 方法(請求項4記載の Al.O.基セラミックスの製造方 法) では、SiC ウイスカを5~30w1%含有すると共に、 焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y, 希土 類元素の酸化物の1種または2種以上を3~30wi%含有 し、基材として Al.O. 基セラミックス原料粉末を含有す る混合体を成形した後、窒素を含有する不活性ガス雰囲 気中において1500~1900℃で常圧焼結するようにしてお り、従って、複雑形状及び大型のものの製造が可能な常 圧焼結法を基本工程として、充分な強度・靭性を有する と共に充分緻密な焼結体よりなるSiC ウイスカ含有 Al, 0. 基セラミックスを製造し得る。

【0025】又、本発明に係る Al:0,基セラミックス (請求項1記載の Al.O.基セラミックス) では、SiC ウ イスカを5~30w1%含有すると共に、焼結助剤としてM g, Si, Ca, Ti, Zr, Cr, Ni, Y及び希土類元素の酸化 物の1種または2種以上を3~30wi%含有し、且つ窒素 含有量が0.2w1%以上である Al,0,基焼結体よりなるよう が減少し、 Al. 0, 本来の優れた特性が失われてしまう。 50 にしており、従って、常圧焼結法を基本工程として得ら

れるSiC ウイスカ含有 Al.O.基セラミックスであって、 充分な強度・靭性を有すると共に充分緻密なものであ

【0026】更に、上記混合体中に元素周期表のIVa、 Va、VIa 族の遷移元素の1種以上とC、N、Bの1種以 上とからなる化合物の1種または2種以上を 0.5~40wt %含有させると、その化合物の一部が Al, 0, 結晶粒内に とりこまれ、常圧焼結後の冷却時に該化合物と Al.O,と の熱膨張率差により Al.O.結晶粒内に転位が発生し、そ の結果、得られる Al. 0. 基セラミックスの強度及び靭性 10 が向上し、より一層強度及び靭性に優れた Al,0,基セラ ミックスとなる。 (請求項5記載の Al, 0, 基セラミック スの製造方法、請求項2記載の Al, O, 基セラミック ス). このとき、化合物の含有量を 0.5~40wt%として いるのは、 0.5w1%未満にすると上記強度及び靭性の向 上効果が発揮されず、40v1%超にすると相対的に Al.O, 量が減少し、Al.O, 本来の優れた特性が失われてしまう からである。

【0027】尚、請求項2記載の Al,0,基セラミックス において、窒化物中窒素以外の窒素含有量とは、上記化 20 合物として窒化物(上記遷移元素とNとからなる化合 物)が含有される場合には該窒化物を構成するN以外の 窒素の含有量のことであり、窒化物が含有されない場合 には請求項1記載の Al.O. 基セラミックスの場合と同 様、 Al, 0, 基焼結体中の窒素含有量のことである。

【0028】本発明に係る Al, 0, 基セラミックス (請求 項1及び2記載の Al, O, 基セラミックス) は、前記の如 く充分な強度・靭性を有すると共に充分緻密な Al.0,基 焼結体よりなるが、この焼結体の気孔率が1%以下のと を有するものとなるので、焼結体の気孔率を1%以下に することが望ましい(請求項3記載の Al, O, 基セラミッ クス)。尚、気孔率が1%超のものは1%以下のものに 比べれば、気孔が破壊の起点となり強度が低いという傾 向にある。

【0029】かかる気孔率1%以下のものは、前記常圧 焼結後に得られる焼結体を更にHIPすることにより得る ことができ、特に常圧焼結後の焼結体の気孔率が5%以 下のとき、これをHIP することにより確実に気孔率1% 以下にし得る。このとき、真空中又はArガス雰囲気中で 40 HIP するよりも、窒素含有不活性ガス雰囲気中でHIPす る方が、前記常圧焼結の場合と同様の理由により、気孔 除去効果が大きく(緻密化され易く)、気孔率を小さく し易い。又、HIP の際の温度は、1200℃未満では気孔除 去され難くなり、1700℃超では Al. 0, の粒成長により強 度・靭性が低下する傾向にあることから、1200~1700℃ とすることが望ましい。従って、前記常圧焼結後に得ら れる焼結体を、更に窒素を含有する不活性ガス雰囲気中 において1200~1700℃でHIP して焼結体気孔率を1%以 下にすることが望ましい(請求項 6 記載の  $\dot{A}$ 1:0,基セラ 50 径:0.6 ~1.0  $\mu$ m にすることが望ましい。

ミックスの製造方法)。 尚、上記窒素含有不活性ガス雰 囲気の圧力は、500 気圧未満では気孔を除去し難くなる 傾向にあり、2000気圧超ではセラミックス中に不必要な 残留応力がのこる傾向にあることから、500~2000気圧 とすることが望ましい。

【0030】本発明において、焼結助剤としてMg, Si, Ca, Ti, 2r, Cr, Ni, Y及び希土類元素の酸化物の1種 以上を 3~30w1%含有するが、この中でも MgOを0.2~ 10wi% 、2r0,を0.2 ~20wi% 且つY,0,を1.0 ~20wi% 含 有すると共に、これらの合計含有量が20岁1%以下である 場合、SiC ウイス力を比較的多く含有 (例えば15♥1%以 上含有)するときでも得られるアルミナ基セラミックス はより緻密なものとなり、又、硬さが非常に高いものと なる (請求項7記載の Al.O.基セラミックス)。 これ は、焼結助剤として上記 MgO、2r0,且つY,0,を上記量で 使用すると、焼結がより促進されつつ、粒成長が抑制さ れて硬さが充分に保持されるためである。尚、上記量よ りも少ないと、焼結促進効果が充分に現れず、多過ぎる と焼結助剤の比率が高くなり過ぎて Al, O, のもつ本来の 硬さが失われてしまうので、上記の如き量にしている。 ここで、上記 MgO、ZrO,且つY,O,の合計含有量として は、上記効果をより確実に高めるために、更に10~15w1 % にすることが望ましく、特には8~12vi% にすること が望ましい。

【0031】更に、本発明に係る Al, 0, 基セラミックス の強度及び靭性に及ぼす Al.O.基焼結体のマトリックス のAl,O, 粒径及びSiC ウイスカの形状の影響を研究した ところ、Al, 0, 粒径については5μm 超の場合にその粒 子が破壊の起点となり強度が低下する傾向があることが き、強度・靭性が特に高く、より確実に高強度・高靭性 30 わかった。従って、かかる粒径による強度低下を抑える にはA1,0, 基焼結体でのA1,0, 粒径については5μm以 下にすることが望ましい(請求項8記載の Al.O.基セラ ミックス)。このような粒径の Al.O,基セラミックス は、Al, 0, 基セラミックス原料粉末として粒径 5 μ m 以 下のものを用い且つ製造条件を適宜制御することにより 得られる。

> 【0032】一方、SiC ウイスカの形状については平均 アスペクト比: 3以上、直径:0.4~1.5 μ π にするこ と(請求項9記載の Al,O,基セラミックス)により、 A 1,0,基セラミックスの靭性及び強度をより向上し得るこ とがわかった。ここで、SiCウイスカは Al.O.基セラミ ックス使用時のクラックの橋渡し(クラックブリッジン グ)をし、このクラックの進展を阻止する働きがある。 かかる働きは、SiC ウイスカの直径が0.4 μ m 未満では 小さく、直径が大きくなるほど大きくなるが、 $1.5~\mu$ m 超ではSiCウイスカ自体が破壊の起点となり、靭性は向 上しても強度が低下する。又、アスペクト比が3未満で は、かかる働きが小さい。尚、一層の靭性及び強度向上 を図るにはSiC ウイスカのアスペクト比: 4以上、直

【0033】本発明に係るSiC ウイスカの含有量は前述の如く5~30w1%にする必要があるが、10w1%超の場合はウイスカ同士がぶつかり合ってつくるネットワーク構

造により常圧焼結時の収縮が阻害され、焼結性が低下する傾向があるので、かかる焼結性の低下を来さなくするにはSiC ウイスカ含有量は10 wt %以下にするとよいが、

そうすると同時に靭性及び強度の向上が制限され、従って、上記10wt%超の場合の焼結性低下を防止することが望まれる。そこで、その防止対策を研究したところ、Si

C ウイスカの平均アスペクト比と AI,0,基焼結体中含有 10 量との積を400以下にすることにより、SiC ウイスカ含

有量:10w1%超の場合であっても焼結性が低下しないことがわかった。従って、上記積を400以下にすることに

より、焼結性の低下を招くことなくSiC ウイスカ含有

量:10~30w1%にでき、それにより一層の靭性及び強度 の向上が図れる(請求項10記載の Al.0,基セラミック ス)。ここで、上記積を400 超にするとウイスカ同士の

ぶつかり合いが多くなり、その反発力のため、上記焼結 性の低下を防止する効果が小さくなる。尚、より安定的

に常圧焼結後の気孔率を5%以下とする点からは上記積 20 を300 以下にすることが望ましい。

して強度が低下する。尚、より強度を向上するには混合

時間 t:4~100 時間とすることが望ましい。

【0035】前記混合体を得るための混合を湿式混合法により行う場合、得られた混合体を成形前に乾燥する。この乾燥は、従来混合体を金属製パットに入れて数時間かけて静置乾燥するパット乾燥法により行われていても静置乾燥の間にSiC ウイスカ同士が凝集し、従って、最もいに極めて不均一な組織となり、強度及び朝性が著しく低下する。これに代えて、スプレー乾燥法により行うと、ウイスカの凝集が起こる前にすばやく乾燥できるため、乾燥時のSiC ウイスカ凝集が起こり難く、従って、得られる Al,0,基セラミックスはSiC ウイスカ均一性に優れ、朝性及び強度が向上する(請求項12記載の製造方法)

【0036】一般にセラミックスのプレス成形では成形 50 例のNo.5(常圧焼結体)に比し、気孔率が小さく、曲げ

圧力1~2ton/cm<sup>1</sup> で成形するのが常識であるが、本発 明に係る混合体の成形の際の成形圧力については3.0ton /cm<sup>2</sup>以上とすることが望ましい(請求項13記載の製造方 法)。これは、成形圧力と成形体の焼結後に得られる焼 結体密度との関係を調べていたとき、SiC ウイスカのよ うな短繊維を含有する混合体をプレス成形する場合に は、通常の成形圧力 (1~2 lon/cm)ではSiC ウイズカ の影響で成形体密度が上がり難く、これよりも高い3.01 on/cm<sup>1</sup>以上にすると成形体密度を向上し得ることを見出 したことに基づくものである。具体的には、成形体密度 が焼結体理論に対する相対密度で、通常の成形圧力のと き50%以下であるのに対し、3.0tom/cm<sup>2</sup>以上のときは53 %以上になる。このように成形体密度が向上すること は、粉末同士の接点及び/又はSiCウイスカと粉末との 接点の数が増えることであり、そのため焼結時の緻密化 がされ易くなり、引いては靭性及び強度が向上する。こ のとき、成形圧力が高いほど靭性及び強度が向上し、そ の点からは4.0ton/cm<sup>2</sup>以上にすることが好ましいが、割 れ発生の防止の点から10ton/cmi 以下にすることが望ま しい。尚、本発明に係る混合体の成形は金型プレス成形 法、冷間等方圧プレス成形法等により行うことができ

[0037]

【実施例】

(実施例1) AI, 0, 粉末(基材としての AI, 0, 基セラミックス原料粉末)、SiC ウイスカ及び焼結助剤を湿式混合し、次いでスプレー乾燥した後、金型を用いてプレスにより加圧成形し、成形体を得た。次に、この成形体を窒素ガス(N,) 雰囲気中において1500~1900℃で常圧焼結し、焼結体(以降、常圧焼結体という)を得た。これら焼結体の一部については、更にHIP した(該HIP 後のものを、以降HIP 材という)。ここで、SiC ウイスカの含有量、焼結助剤の種類及び含有量、常圧焼結条件(温度、時間)、HIP 条件(温度、時間、圧力)は表1に示す通りであり、種々変化させた。

【0038】このようにして得られた常圧焼結体及びHIP材(いづれも Al. 0. 基セラミックス)について、気孔率、曲げ強度及び破壊靭性を測定し、又、窒素含有量を分析した。ここで、気孔率については、アルキメデス法 により密度を測定し、その密度測定値から求めた。曲げ強度は、3点曲げ試験により測定した。破壊靭性は、1F法(Indentation fracture法)によりJIS に準拠して測定した。窒素含有量は不活性ガス溶融法により分析した。これら測定結果を表2に示す。比較例のもの(本発明に係る要件から外れるもの)では、全般的に気孔率が大きく、曲げ強度及び破壊靭性値が低いが、これに対し、本発明の実施例(本発明に係る要件を充たすもの)では、全般的に気孔率が小さく、曲げ強度及び破壊靭性値が高い。尚、比較例のNo. 2(HIP材)は本発明の実施例のNo. 50 例のNo. 5 (常圧焼結体)に比し、気孔率が小さく、曲げ

強度が高いが、これはHIP の有無によるものである。そ れでも破壊靭性値については、前者のものは後者のもの

【0039】 (実施例2) 実施例1と同様の方法によ り、常圧焼結体及びHIP 材を得た。ここで、SiC ウイス 力の含有量、焼結助剤の種類及び含有量、常圧焼結条件 等は表3に示す通りであり、種々変化させた。そして、 これら常圧焼結体及びHIP 材について実施例1と同様の 測定を行った。これら測定結果を表 4 に示す。比較例に 係るものに対し、本発明の実施例に係るものは、全般的 10 に気孔率が小さく、曲げ強度及び破壊靭性値が高い。

【0040】 (実施例3) Al,0,粉末、SiC ウイスカ及 び焼結助剤、TiC 又はVC (遷移元素であるTi又はV とC とからなる化合物)を湿式混合した後、実施例と同様、 スプレー乾燥、成形、常圧焼結して焼結体を得、又、そ の一部はHIP しHIP 材を得た。ここで、SiC ウイスカの 含有量、焼結助剤の種類及び含有量、TiC 又はVCの含有 量、常圧焼結条件等は表5に示す通りであり、種々変化 させた。そして、これら常圧焼結体及びHIP 材について に示す。比較例に係るものに対し、本発明の実施例に係 るものは、全般的に気孔率が小さく、曲げ強度及び破壊 靭性値が高い。

【0041】 (実施例4) 表7に示す配合量で Al, 0, 粉 末、SiC ウイスカ及び焼結助剤等を湿式混合した後、成 形した。次に、この成形体を窒素中1500~1900℃で常圧

焼結した後、N:中でHIP した。そして、これらについて 実施例1と同様の測定を行い、更に硬度測定も行った。 尚、硬度はマイクロピッカース硬度計を用いてJIS に準 拠して測定した。これら測定結果を表8に示す。この表 8に示される実施例のものは請求項7記載の Al. O. 基セ ラミックスに係るものであり、機械的性質に優れ、硬さ も高い。これに対して表8に示される比較例1~3のも のは焼結助剤の種類が異なることに起因して機械的性質 が劣り、特に硬さが低く、又、比較例4のものは焼結助 剤の種類は同様であるが、その含有量が多いことに起因 して硬さが低く、又、比較例5のものは焼結助剤の含有 量が少ないことに起因して緻密性が劣り、従って機械的 特性が低い。

12

【0042】 (実施例5) 前記実施例4において表7の D-2 に示した Al. O. 基焼結体は強度:96kg/mm²、靭性: 4.9MPam<sup>1/2</sup> である(表8)。この焼結体のマトリック ス(Al, O<sub>1</sub>) の粒径を測定したところ、粒径:1.2μm であ った。一方、 Al, O, 基セラミックス原料粉末として、こ の D-2の場合よりも粒径の大きなものを用い、この点を 実施例1と同様の測定を行った。これら測定結果を表6 20 除き D-2の場合と同様の製造法により同様組成を有する Al.O, 基焼結体を得、そのマトリックス粒径、強度及び 靭性を測定したところ、粒径:7.5μm 、強度:34kg/m m'、靭性:5.7MPam'/' であった。

[0043]

【表1】

14

		SiC ofab :wt%	化合 物 :wt%	焼結助 剤 : wt%	成形法	焼結条 件	HIP 条件
実	1	10	_	MgO :2 Y <sub>2</sub> O <sub>2</sub> :4	金型 ルス	1750℃ ×1hr, N.中	1500℃× 1hr,1500 atm,N,中
施	2	12. 5		ZrO::4 MgO:8	同上	1800℃ ×1hr, N.中	同上
例	3	15	_	TiO1:4 ZrO1:6	同上	1850℃ ×1hr. N₁中	同上
А	4	20		MgO:2 ZrO::4 Y <sub>2</sub> O::8	同上	1750℃ ×1hr, N.中	同上
	5	10	-	\$i0::5 Y:0::3	同上	1700℃ ×1hr, N.中	_ (:HIP 변화)
比	1	15	_	SiO::8 Y:0::4	同上	1800℃ ×1hr, Ar中	1500℃× 1hr, N,中
较	2	3		MgD :2 Y.O.:4	同上	1750℃ ×1hr, N.中	同上
例	3	35	_	MgO :2 Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :4	同上	1800℃ ×1hr, N.中	同上
а	4	15	_	NgO :12 Y.O.:24	配	同上	同上
	5	15	-	SiO::0.5 Y:0::1.5	同上	同上	同上

[0044]

### 【表 2 】

				1224	
		N₂ <b>量</b> : %	気孔率	強度 :kg/mm'	靱性 :MPam'/'
実	1	0.6	0.2	80	4.3
施	2	0.9	0.2	8 4	4. 9
<del>8</del> 1	3	1.2	0.3	80	5.1
Α	4	1.2	0.6	80	5, 5
	5	0.5	2.0	65	4.4
比	1	0.09	2.9	42	3. 2
較	2	0.8	0.08	71	3. 1
例	3	0.9	7.8	31	測定不可
а	4	2. 1	1.2	36	2.9
	5	0.2	10.5	25	測定不可

							3
		SiC ウイスカ :wt%	化合物:wt%	焼結助 剤 :Wt%	<b>戍形</b>	焼結 条件	H I P 条件
実	1	10	-	MgO :2 Y,O.:4	金型ルス	1750℃× 1hr. N.中	1500℃×1hr, 1500atm, N,中
施	2	12.5	_	Zr0.:4 Mg0:8	同上	1800℃× lhr, N, 中	同上
例	3	15	-	Si0::8 Y:0::4	譿	配上	同上
В	4	12. 5	TiC :4	同上	金型	同上	同上
	5	15	_	Ti0::4 Zr0::6	同上	1850℃× 1hr, N.中	同上
	6	20	_	MgO :2 ZrO::4 Y:0::8	同上	1750℃× 1hr.N.中	同上
	7	10		SiO.:5 Y.O.:3	同上	1700℃× 1hr. N₂中	 (:HIP ਦਾਭਾ)
	8	12. 5	_	\$i0::8 Y:0::4	鏡込 截形	1800℃× 1hr.N:中	1500℃×1hr, 1500atm, N:中
比	1	3	_	MgO :2 Y.O.:4	魏	1750℃× 1hr. Ar中	1500℃×1hr, N <sub>z</sub> 中
較	2.	35	_	同上	同上	1800℃× 1hr.N.中	同上
例	3	15	1	MgO :12 Y.O.:24	同上	同上	同上
þ	4	15	-	Mg0 :0.5 Y,0,:1.5	同上	同上	同上
	5	15	_	SiO <sub>2</sub> :8 Y <sub>1</sub> O <sub>3</sub> :4	同上	1800℃× 1hr, Ar中	1500℃×1hr, Ar中
	8	15	-]	同上	同上	1400℃× 1hr. N.中	1500℃×1hr, N.中
	7	15	_	同上	同上	2000℃× 1hr. N₂中	同上

[0046]

30 【表4】

1					
		N₁ <b>±</b> : %	気孔率	強度 :kg/mm'	数性 :MPam'/*
	1	0.6	0.2	80	4, 3
実	2	0.9	0.2	84	4. 9
施	3	1, 2	0.1	95	5, 1
<b>9</b> 1	4	1.3	0,1	89	5.0
В	5	1, 2	0.3	80	5. 1
	6	1.2	0.6	80	5. 5
	7	0.5	2.0	65	4. 4
	8	0.8	0.1	83	5. 2
	1	0.8	0.08	71	3, 1
比	2	0.9	7.8	31 -	測定不可
較	3	2.1	1.2	36	2. 9
例	4	0.21	10.5	25	測定不可
b	5	0.09	2. 9	42	3. 2
	6	2.0	15.8	22	測定不可
	7	2.4	6.5	30	3.1

[0047]

【表 5 】

		SiC ウイスカ :wt%		焼結助 剤 :wt%	成形法	焼結条 件	HIP 条件
実	1	10	TiC :4	\$i0::5 Y:0::3	金型ルズ	1750℃ ×1hr, N₁中	1500℃× 1hr, 1500 atm, N,中
施	2	15	TiC :8	Mg0 :4 Y,0,:8	同上	同上	同上
例	3	15	VC :4	Mg0 :4 Zr0::8	同上	同上	同上
С	4	20	TiC :4	MgO :4 Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :8	同上	<b>同上</b>	同上
	5	10	TIC :4	SiO::5 Y:0::3	同上	同上	 (HIP#f)
比	1	15	TiC :8	MgO :4 Y:0::8	同上	1750℃ ×1hr, Ar中	1500℃× 1hr,1500 atm,Ar中
較	2	3	TiC :4	SiO <sub>2</sub> :5 Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :3	同上	1750℃ ×1hr. N.中	1500℃× 1hr, 1500 atm, N,中
例	3	35	TiC :4	SiO.:5 Y.O.:3	同上	同上	同上
С	4	10	TiC :4	SiO::0.5 Y:0::1.5	同上	同上	同上
	5	10	TiC :4	SiOz:12 YzOz:24	同上	同上	同上

[0048]

【表 6 】

				1207		
		N.量 : %	気孔率	強度 :kg/mm <sup>r</sup>	物性 :MPam'/'	
実	1	1.0	0.1	92	4, 1	
英施 例 C	2	1.2	0.2	84	4.9	
	-3	1.4	0.2	82	5.0	
	4	.1, 0	0,5	80	5.5	
	5	0.5	3, 5	75	4.8	
比	1	0.08	3.4	60	4.0	
較	2	0.9	0.1	82	3.1	
	3	0.9	11.1	28	測定不可	
例	4	1, 6	8.6	30	測定不可	
C	5	1.2	0.5	42	2.8	

[0049]

		SiC ウイスカ :wt%	化合 物 :wt%	焼結助剤 :wt%	焼結 条件	H I P 条件
実	1	15	-	MgO :1, ZrO,:2, Y,O,:4	1750℃× 1hr	1450℃ ×1hr
施	2	15	TiC :4	MgO :1. ZrO::2, Y:0::4	1800℃× 1hr	同上
例	3	15	TiC :8	Mg0 :1.4, Zr0,:3, Y.0,:6	1820℃× 1hr	同上
D	4	20	_	MgO :1.8, ZrO::4, Y:0::8	1750℃× 1hr	同上
	5	15	VC:2 WC:4	MgO :1, ZrO::2, Y:0::4	1750℃× 1hr	同上
	6	10	TiN :4	MgO :1.8, ZrO::4, Y.O::8	1750℃× 1hr	同上
	7	12,5	TiB: :10	MgO :1.8. ZrO::4, Y:0::8	1770℃× 1hr	同上
比	1	15	_	MgO :1.4, YzO::6	1750℃× 1hr	同上
較	2	15	_	SiO: :4. Y:0: :4	1800℃× 1hr	同上
例	3	15	_	MgO :1.4, ZrO::6	1750℃× 1hr	同上
d	4	15		MgO :5, ZrO::10, Y:0::15	1750℃× 1hr	同上
	5	15	-	NgO:0.1, ZrOz:0.1 YzOs:0.5	1800℃× 1hr	同上

[0050]

[0051]

## 【表 8】

		N. <b>±</b> :%	気孔率 :%	強度 :kg/mm*	靱性 :MPam'/1	硬度 Hv
実	1	0.4	0. 0	100	5, 4	1820
施	2	0.8	0. 2	96	4. 9	1900
例	3	1. 0	0. 1	110	5. 4	2100
D	4	0.7	0.3	8 6	5. 1 <sup>-</sup>	1880
	5	0.5	0.0	100	5. 6	2050
	6	1. 7	0. 2	8 8	4.8	1900
	7	0.6	0.3	8 5	4. 9	1950
比	1	0. 6	0.2	7 6	4. 4	1670
較	2	0. 5	0.8	7 1	4. 2	1610
例	3	0.8	1. 2	68	4. 3	1590
d	4	1. 2	0. 2	7 0	4. 6	1600
	5	0. 3	7. 2	4 6	4. 6	1520

		Sic	ウイス:	<b>カ</b>	混合時間	気孔率	強度	破壊
		径 : μm	アスペ クト比	含有量 : wt%	ョ) : Hr	: %	: kg/mm²	靱性値 :MPam'/*
	<b>を例</b> - 2	0.8	15	15	20	0. 2	96	4. 9
	1	0. 2	15	15	20	0. 2	83	3. 0
比	2	2. 0	15	15	20	0.2	62	5, 5
較	. 3	0.8	2	15	240	0.2	68	2.7
例	4	0.8	50	15	5	8.8	35	測定不可
E	5	0.8	30	25	20	21. 1	23	測定不可
	6	0.8	60	5	1	0. 1	43	3. 2

[0052]

[実10]

					(&IU)			
		化合物 : wt%	成形方 法	成形圧力 : ton/cm <sup>z</sup>	焼結条件 (雰囲気: 全てN <sub>2</sub> 中)	HIP 後 密度 :%	曲げ強度: kg/mm*	破壊 靱性値 :MPam'/'
実	1	_	金型がな	3	1750℃×1hr	99. 9	98	5. 2
~	2		金型ルス	4.5	1750℃×1hr	100	100	5.4
施	3	TIC:4	金型がな	4.5	1800℃ × 1hr	100	96	4.9
例	4	VC :2 WC :4	金型がな	4.5	1750℃×1hr	99. 9	100	5, 6
F	. 5	_	CIP	3	1750℃×1hr	99.8	90	5. 1
	6	_	CIP	4.5	1750℃×1hr	100	95	5.1
比較	1	_	金型ルス	1.5	1750℃×1hr	94.1	48	4. 1
例の	2	_	CIP	1.5	1750℃×1hr	93.9	40	4. 0
	3	TiC:4	金型がな	1.5	1800℃×1hr	93, 5	42	3. 9

注)HIP 条件 ---- 全て、N₂中, 1500℃×1hr, 1500atm

【0053】 (実施例6) 前記D-2 の Al,0,基焼結体を ベースとし、SiC ウイスカの直径、平均アスペクト比、 SiC ウイスカの含有量 c、ボールミルによる原料混合時 間t、気孔率をパラメータとして表9に示す如く変化さ せ、かかる点を除き D-2の場合と同様の製造法により同 様組成を有するAl,O,基焼結体を得、それらの強度及び 靭性を測定した。その結果、表9からわかる如く、ベー スのD-2 のAl:0, 基焼結体は、SiCウイスカの径:0.8μm 、アスペクト比:15 、含有量 c:15%、混合時間 t:20 時間、気孔率:0.2、強度:96kg/mm²、靭性:4.9MPam'/' である。これに対し、比較例のAl, O, 基焼結体 (El~6) の中、ElのものはSiC ウイスカ径:0.4μm 未満のため強 50 により行っており、強度:96kg/nm²、 靭性:4.9MPam¹/゚

度は同程度であるが靭性が低く、E2のものはSiC ウイス 40 カ径:1.5μm 超のため靭性は高いが強度が低い。E3のも のは混合時間 t:200時間超のためアスペクト比:3未満 となり、強度、靭性とも低い。E4、E5のものは、混合時 間 t < 2 c - 20であるためアスペクト比が大きく、アス ペクト比とSiC ウイスカの含有量 c との積:400超のため 緻密化せず、気孔率が大きい。E6のものは混合時間 t: 2 時間未満であることに起因して組織が不均一となるた め、強度が低い。

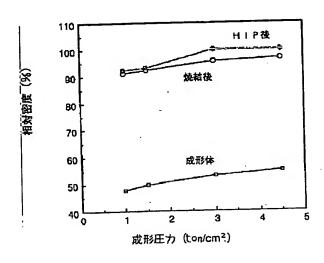
【0054】 (実施例7) 前記D-2 の Al.0,基焼結体 は、原料の湿式混合後の混合体の乾燥をスプレー乾燥法 25

である。このスプレー乾燥法に代えてバット乾燥法を適用し、かかる点を除き B-2の場合と同様の製造法により同様組成を有するA1.0, 基焼結体を得、それらの強度及び靭性を測定したところ、強度: $37 \, \mathrm{kg/mn}^2$ 、 靭性: $4.2 \, \mathrm{MP}$   $an^{1/2}$  であった。

【0055】(実施例8)前記D-2の場合と同様配合の混合体について、金型プレス成形または冷間等方圧プレス成形 (以下CIP)する際の成形圧力が成形体密度、焼結体密度及び HIP後の密度に及ぼす影響を調べた。その結果を図1 (成形:金型プレス成形)及び図2 (成形:CI 10P)に示す。成形圧力が高いほど成形体密度が高く、それに伴って焼結体密度も高くなり、HIP 後の密度は、成形圧力:3.01on/cm<sup>2</sup>以上のとき相対密度で100%近くに達している。

【0056】(実施例9) SiC ウイスカ:15v(%を含み、焼結助剤としてMg0:1v(%, 2r0,:2v(%, Y,0,:4v(%を含有し、基材として Al,0,基セラミックス原料粉末を含有し、或いは更に表10に示す化合物を含有する混合体を、表10に示す条件で成形、常圧焼結、HIP し、得られた Al,0,基セラミックスについて密度、曲げ強度及び破壊靭性値を測定した。その結果を表10に示す。F1~6 のものは、成形圧力:3.0ton/cm<sup>2</sup> 以上であるため、強度及び靭性が高い。これに比し、G1~3 のものは成形圧力:3.0ton/cm<sup>2</sup> 未満であるため、強度及び靭性が低い。

[図1]



[0057]

【発明の効果】本発明に係る Al. 0. 基セラミックスの製造方法は、ホットプレスではなく複雑形状及び大型のものの製造が可能な常圧焼結法を基本工程として、充分な強度・靭性を有すると共に充分緻密な焼結体よりなるSi C ウイスカ含有 Al. 0. 基セラミックスを製造し得、従って、充分強度・靭性に優れると共に緻密である複雑形状又は/及び大型のSiC ウイスカ含有 Al. 0. 基セラミックスが得られるようになるという効果を奏する。

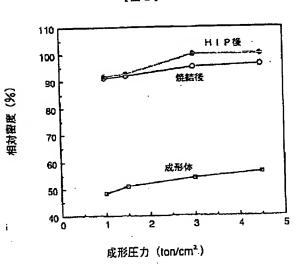
[0058] 本発明に係る Al, 0, 基セラミックスは、常圧焼結法を基本工程として得られるSiC ウイスカ含有 Al, 0, 基セラミックスであって、充分な強度・靭性を有すると共に充分緻密なものであり、従って、複雑形状又は/及び大型であり、且つ高強度・高靭性が必要な部品あるいは機器の構成材料として好適に使用し得、それらの性能、機能及び耐久性を向上し得るようになるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例8に係る混合体の金型プレス成形の際の成形圧力と、成形体、焼結後及びHIP 後の相対密度との関係を示す図である。

【図2】 実施例8に係る混合体の冷間等方圧プレス成形の際の成形圧力と成形体、焼結後及びHIP後の相対密度との関係を示す図である。

[図2]



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

·
☐ BLACK BORDERS
MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.